**填空**

1. 理想气体 状态方程pV=(M/μ)RT中μ是 。
2. 随着气压的降低平均自由程 。
3. 泵可以在大气压下工作。
4. 电离真空规可以测量 真空。
5. 当磁场强度一定时，带电粒子回旋运动的频率与速度 。
6. A的激发电位大于B的电离电位，受激亚稳原子A\*与B原子碰撞后B变为离子，此为 电离。
7. 非自持放电转化为自持放电的条件为 。
8. 低温等离子体中，电子温度比离子温度 。
9. 等离子体的振动频率由 决定。
10. 等离子体自偏压与电极面积的四次方成 比。
11. 温度增加， 临界晶核尺寸 ， 形成临界晶核的势垒增加。
12. 随着离子能量的增加， 溅射产额 ，达到一个最大值后继续增加离子能量溅射产额下降。
13. 磁控溅射源结构共性：（1） 磁场与电场垂直；（2）磁场方向与阴极（靶） 表面 。
14. 蒸发镀膜时点源的沉积均匀性比面源 。
15. 蒸发镀膜时残余气体造成的杂质含量与气压成正比，与生长速率成 比。
16. 等离子体CVD的突出优点是沉积温度 。
17. 反应是利用不同温度下，不同价化合物稳定性的差异实现元素的沉积。
18. 利用氩等形成的离子或等离子体进行物理溅射产生的刻蚀为 刻蚀。
19. 干法刻蚀的机制包括物理机制、化学机制和 物理化学机制 。
20. 氢氟酸对SiO2的刻蚀速率比对Si刻蚀速率 。